

Крикун К.Ю., Ковтун Н.А., Хрипунов Г.С., Україна, Харків

РОЗРОБКА ПЛІВКОВИХ ЕЛЕКТРОДІВ ІТО ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ

У доповіді наведені результати розробки технології отримання шарів ІТО для створення оптоелектронних пристроїв. Проведені оптичні та електричні дослідження плівок, нанесених методом вакуумного неактивного магнетронного напилення. Визначено оптимальний режим нанесення шарів ІТО при температурі підкладки – 300 °С та парціальному тиску Ar - $1,7 \cdot 10^{-2}$ мм.рт.ст.

Крикун К.Ю., Ковтун Н.А., Хрипунов Г.С., Україна, Харків

РАЗРАБОТКА ПЛЁНОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ИТО ДЛЯ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

В докладе приведены результаты разработки технологии получения слоёв ІТО для создания оптоэлектронных приборов. Проведены оптические и электрические исследования плёнок, нанесённых методом вакуумного неактивного магнетронного напыления. Определён оптимальный режим нанесения слоёв ІТО при температуре подложки - 300 °С и парциальным давлением Ar - $1,7 \cdot 10^{-2}$ мм.рт.ст.

Krikun K.U., Ukraine, Kovtun N.A., Khripunov G.S., Ukraine, Kharkov

THE DEVELOPMENT OF ITO FILM ELECTRODES FOR OPTOELECTRONIC DEVICES

In report results of technological development of ITO layers for making optoelectronic devices are presented. Optical and electrical research of films deposited by nonreactive magnetron sputtering was conducted. Optimum regime of ITO layer sputtering, when temperature of substrate - 300 °С and partial pressure of Ar - $1,7 \cdot 10^{-2}$ mm Hg is determined.